

## Opis przedmiotu zamówienia podłoży do wzrostu nanostruktur na systemie MBE – Riber Compact21

### I. Podłoża CdZnTe [100], 5% ZnTe

**Rozmiary:**

10mm x 10 mm ( $\pm 0.2$ ) - szt. 20

Grubość –  $800 \pm 50 \mu\text{m}$

**Orientacja:** (100) $\pm 0.3$  stopnie

**Przewodnictwo:** pół-izolacyjne

**Obróbka powierzchni:** Trawienie Nakagawa  $\leq 1 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}$

**Precypitaty:** śr.  $\leq 2 \mu\text{m}$

**Powierzchnia końcowa:** polerowane jednostronnie

### II. Podłoża CdZnTe [112], 5% ZnTe

**Rozmiary:**

10mm x 10 mm ( $\pm 0.2$ ) - szt. 20

20 mm x 20 mm ( $\pm 0.2$ ) – szt. 6

Grubość –  $800 \pm 50 \mu\text{m}$

**Orientacja:** (100) $\pm 0.3$  stopnie

**Przewodnictwo:** pół-izolacyjne

**Obróbka powierzchni:** Trawienie Nakagawa  $\leq 1 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}$

**Precypitaty:** śr.  $\leq 2 \mu\text{m}$

**Powierzchnia końcowa:** polerowane jednostronnie

### III. Podłoża GaAs

**Rozmiary:**

2" ( $\pm 2 \%$ ) – szt. 50

3" ( $\pm 2 \%$ ) – szt. 8

Grubość –  $800 \pm 50 \mu\text{m}$

**Orientacja:** (100) $\pm$ 0.3 stopnie

**Przewodnictwo:** pół-izolacyjne

**Obróbka powierzchni:** Trawienie Nakagawa  $\leq 1 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}$

**Precypitaty:** śr.  $\leq 2 \text{ }\mu\text{m}$

**Powierzchnia końcowa:** polerowane jednostronnie

#### **IV. Podłoża InP**

**Rozmiary:**

2" ( $\pm 2 \%$ ) – szt. 20

3" ( $\pm 2 \%$ ) – szt. 10

Grubość –  $800 \pm 50 \text{ }\mu\text{m}$

**Orientacja:** (100) $\pm$ 0.3 stopnie

**Przewodnictwo:** pół-izolacyjne

**Obróbka powierzchni:** Trawienie Nakagawa  $\leq 1 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}$

**Precypitaty:** śr.  $\leq 2 \text{ }\mu\text{m}$

**Powierzchnia końcowa:** polerowane jednostronnie

**Uwagi dodatkowe:** Dostawca podłoży jest odpowiedzialny za przygotowanie ich do procesu wzrostu na MBE – RIBER COMPACT 21

Zamówienie zostanie zrealizowane w jednej dostawie.

**Kontakt:** Grendysa Jakub, e-mail: [grendysa@univ.rzeszow.pl](mailto:grendysa@univ.rzeszow.pl)